TAVAKOL ELECTRONIC
توکل الکترونیک
مرجع تخصصی تأمین قطعات الکترونیکی اورجینال
این دیتاشیت توسط توکل الکترونیک تهیه و ارائه شده است.
جهت مشاهده قیمت، موجودی و ثبت سفارش این قطعه به وب‌سایت توکل الکترونیک مراجعه فرمایید.
مشاهده قیمت و خرید
برای خرید و مشاهده سایر محصولات کلیک کنید
www.DataSheet4U.com

シリコンNチャンネルMOS形電界効果トランジスタ
(π-MOS)

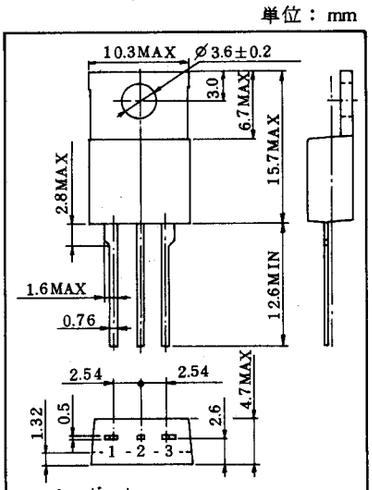
2SK792

通信工業用

単位：mm

○ 高速高電圧スイッチング用
○ スイッチングレギュレータ
○ モータドライブ用

- 高耐圧です。　：$V_{(BR)DSS}$＝900 V
- 順方向伝達アドミタンスが高い。
  ：$|Y_{fs}|$＝1.0 S（標準）（I_D＝1.5 A）
- 漏れ電流が低い。：I_{GSS}＝±100 nA（最大）（V_{GS}＝±20 V）
  I_{DSS}＝300 μA（最大）（V_{DS}＝900 V）
- 取扱いが簡単な，エンハンスメントタイプです。



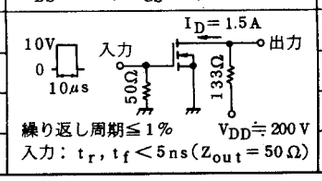
1. ゲート
2. ドレイン（放熱板）
3. ソース

JEDEC	TO-220AB
EIAJ	SC-46
東芝	2-10P1B

最大定格　（Ta＝25℃）

項目		記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧		V_{DSX}	900	V
ゲート・ソース間電圧		V_{GSS}	±20	V
ドレイン電流	DC	I_D	3	A
	パルス	I_{DP}	5	
許容損失（Tc＝25℃）		P_D	100	W
チャンネル温度		T_{ch}	150	℃
保存温度		T_{stg}	−55～150	℃

電気的特性　（Ta＝25℃）

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ゲート漏れ電流		I_{GSS}	V_{GS}＝±20V, V_{DS}＝0	−	−	±100	nA
ドレイン遮断電流		I_{DSS}	V_{DS}＝900V, V_{GS}＝0	−	−	300	μA
ドレイン・ソース間降伏電圧		$V_{(BR)DSS}$	I_D＝10mA, V_{GS}＝0	900	−	−	V
ゲートしきい値電圧		V_{th}	V_{DS}＝10V, I_D＝1mA	1.5	−	3.5	V
順方向伝達アドミタンス		$\|Y_{fs}\|$	V_{DS}＝10V, I_D＝1.5A	0.5	1.0	−	S
ドレイン・ソース間オン抵抗		$R_{DS(ON)}$	I_D＝1.5A, V_{GS}＝10V	−	3.3	4.5	Ω
ドレイン・ソース間オン電圧		$V_{DS(ON)}$	I_D＝3A, V_{GS}＝10V	−	12	15	V
入力容量		C_{iss}	V_{DS}＝25V, V_{GS}＝0, f＝1MHz	−	800	1100	pF
帰還容量		C_{rss}	V_{DS}＝25V, V_{GS}＝0, f＝1MHz	−	70	120	pF
出力容量		C_{oss}	V_{DS}＝25V, V_{GS}＝0, f＝1MHz	−	120	200	pF
スイッチング時間	上昇時間	t_r		−	55	120	ns
	ターンオン時間	t_{on}		−	70	165	
	下降時間	t_f		−	60	120	
	ターンオフ時間	t_{off}		−	280	550	

この製品はMOS構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。

www.DataSheet4U.com